

# HSM83

シリコンエピタキシャルプレーナ形  
シングルダイオード  
高電圧スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR  
HIGH VOLTAGE SWITCHING

## 特長 FEATURES

- 逆電圧が250Vですので高電圧対応品です。
- MPAK外形であるため、面装着及び、高密度実装が可能です。
- High reverse voltage. ( $V_R=250V$ )
- MPAK (EIAJ SC-59) structure enables easy mounting and high reliability.

## 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

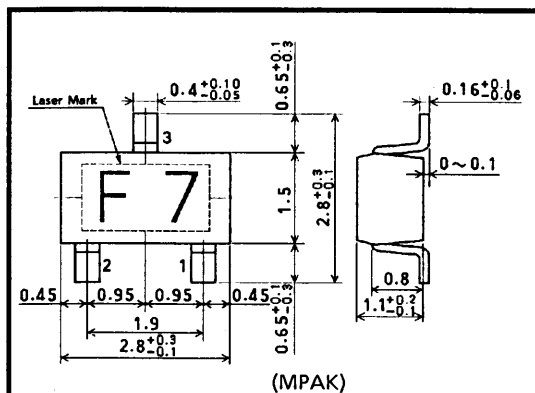
(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a=25^\circ C$ )  
( $25^\circ C$  ambient temperature unless otherwise specified.)

項目	Symbol	HSM83	Unit
せん頭逆電圧	$V_{R(\text{peak})}$	300	V
逆電圧	$V_R$	250	V
せん頭順電流	$I_{F(\text{peak})}$	300	mA
サージ順電流	$I_{F(\text{surge})}^*$	2	A
平均整流電流	$I_O$	100	mA
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ C$
保存温度	$T_{\text{stg}}$	-55~+125	$^\circ C$

\* 持続時間 10ms 以内のサージ電流における許容値

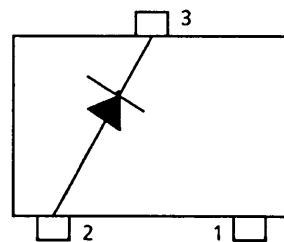
\* Value at duration of 10 msec.

## 外形図



(Dimensions in mm)

1. NC: NC
2. アノード: Anode
3. カソード: Cathode



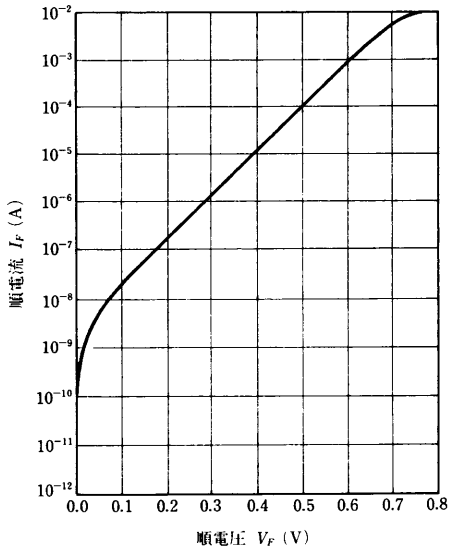
## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a=25^\circ C$ )  
( $25^\circ C$  ambient temperature unless otherwise specified.)

項目	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
逆破壊電圧	$V_{(BR)R}$	$I_R = 100\mu A$	300	-	-	V
逆電流	$I_R$	$V_R = 250V$	-	-	0.2	$\mu A$
順電圧	$V_F$	$I_F = 100mA$	-	-	1.2	V
端子間容量	C	$V_R = 0V, f = 1MHz$	-	-	3.0	pF
逆回復時間	$t_{rr}$	$I_F = I_R = 30mA, I_{rr} = 3mA$	-	-	100	ns

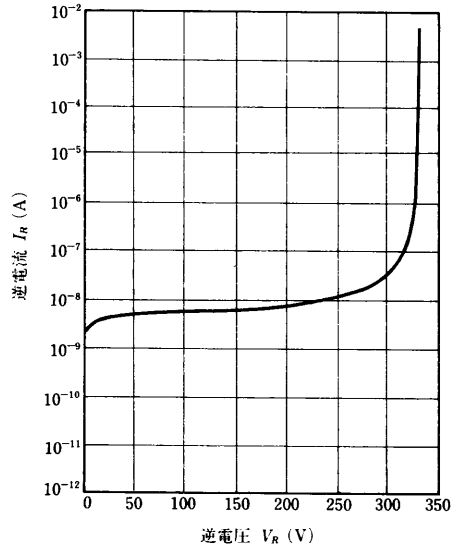
順特性

FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE



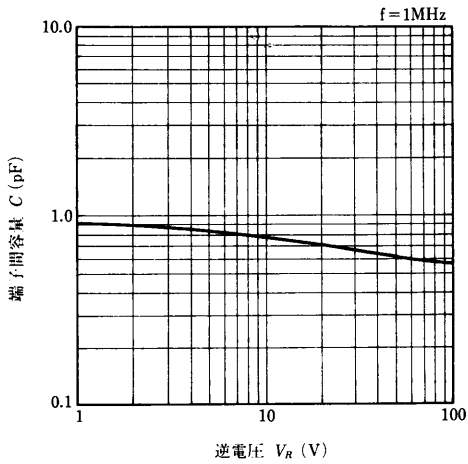
逆特性

REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE



端子間容量 对 逆电压特性

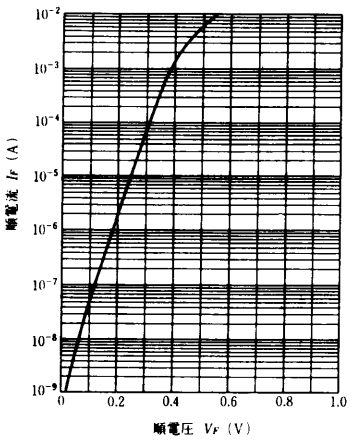
CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE





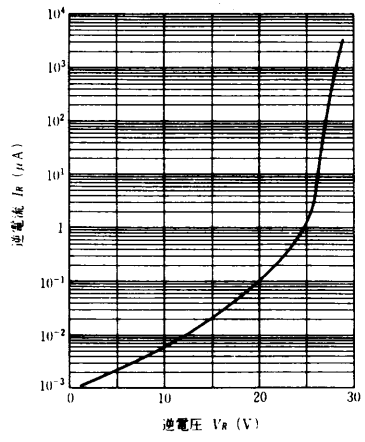
順特性

FORWARD CHARACTERISTICS



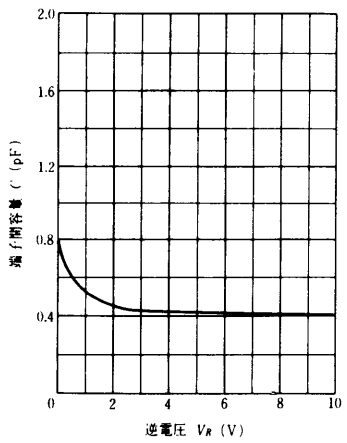
逆特性

REVERSE CHARACTERISTICS



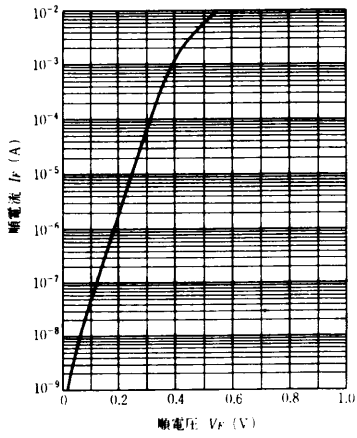
端子間容量对逆电压特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

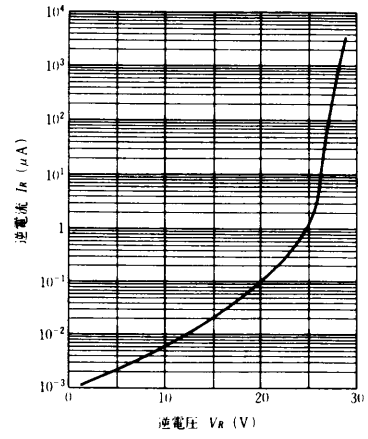




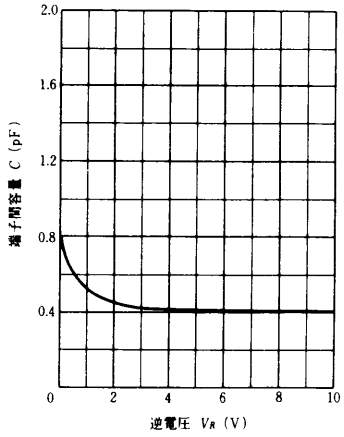
順特性  
FORWARD CHARACTERISTICS



逆特性  
REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量対逆電圧特性  
CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



# HSM88WA

シリコンショットキーバリア形

CATVチューナミキサ用

SILICON SCHOTTKY BARRIER

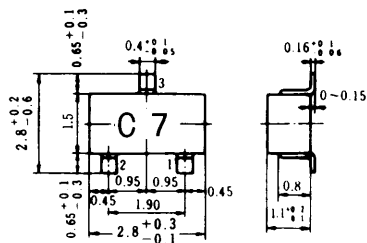
CATV TUNER MIXER

## ■特長

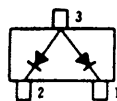
- 高耐圧です。
- MPAK (EIAJ SC-59) 外形のため、面装着により高密度、高速部品実装が可能です。

## ■FEATURES

- Proof against high voltage.
- MPAK structure ensures high reliability.
- Good for surface mounting on printed circuit board.



(MPAK)



1. カソード1 : Cathode 1
2. カソード2 : Cathode 2
3. アノード1 : Anode 1  
アノード2 : Anode 2

Dimensions in mm

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	Symbol	HSM88WA	Unit
逆電圧	$V_R$	10	V
平均整流電流	$I_{o*}$	15	mA
接合部温度	$T_j$	100	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +100	°C

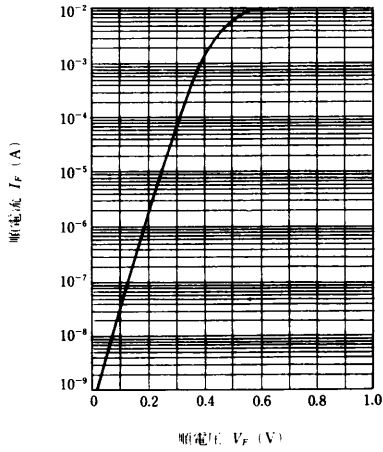
\* 1素子での値

\* per one device

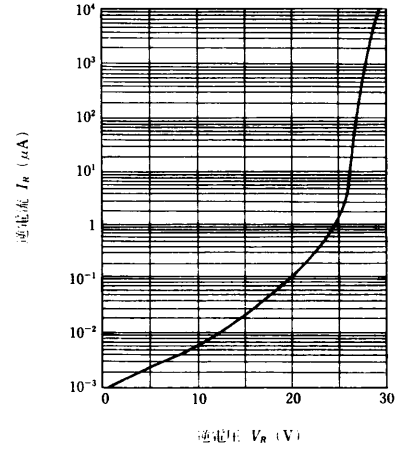
## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
順電圧	$V_F$	$I_F = 1\text{mA}$	350	-	420	mV
		$I_F = 10\text{mA}$	500	-	580	
逆電流	$I_R$	$V_R = 2\text{V}$	-	-	0.2	$\mu\text{A}$
		$V_R = 10\text{V}$	-	-	10	
端子間容量	$C$	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	0.85	pF
順電圧偏差	$\Delta V_F$	$I_F = 10\text{mA}$	-	-	10	mV
組内間容量偏差	$\Delta C$	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	0.10	pF

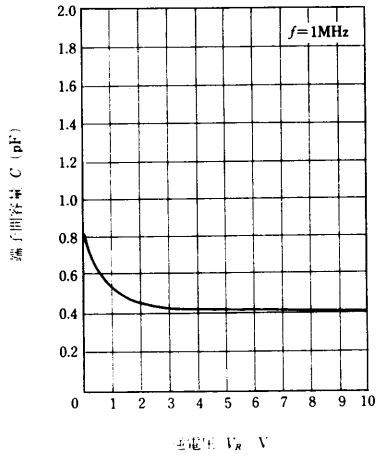
順特性  
FORWARD CHARACTERISTICS



逆特性  
REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量对逆电压特性  
CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE





# HSM88WK

シリコンショットキバリア形

CATVチューナミキサ用

SILICON SCHOTTKY BARRIER

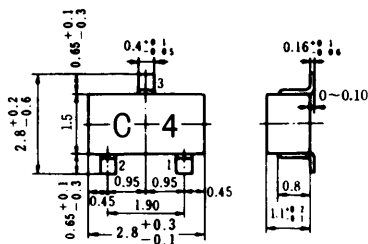
CATV TUNER MIXER

## ■特長

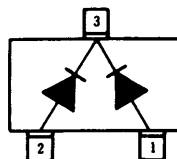
- 高耐圧です。
- MPAK (EIAJ SC-59) 外形のため、面装着により高密度、高速部品実装が可能です。

## ■FEATURES

- Proof against high voltage.
- MPAK structure ensures high reliability.
- Good for surface mounting on printed circuit board.



(MPAK)



1. アノード : Anode
2. アノード : Anode
3. カソード : Cathode

(Dimensions in mm)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	Symbol	HSM88WK	Unit
逆電圧	$V_R$	10	V
平均整流電流	$I_{O^*}$	15	mA
接合部温度	$T_j$	100	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +100	°C

\*1 素子での値

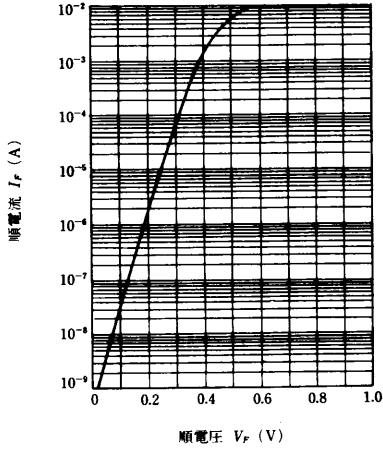
\* per one device.

## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
順電圧	$V_F$	$I_F=1mA$	350	—	420	mV
		$I_F=10mA$	500	—	580	
逆電流	$I_R$	$V_R=2V$	—	—	0.2	$\mu A$
		$V_R=10V$	—	—	10	
端子間容量	C	$V_R=0V, f=1MHz$	—	—	0.85	pF
順電圧偏差	$\Delta V_F$	$I_F=10mA$	—	—	10	mV
組内容量偏差	$\Delta C$	$V_R=0V, f=1MHz$	—	—	0.10	pF

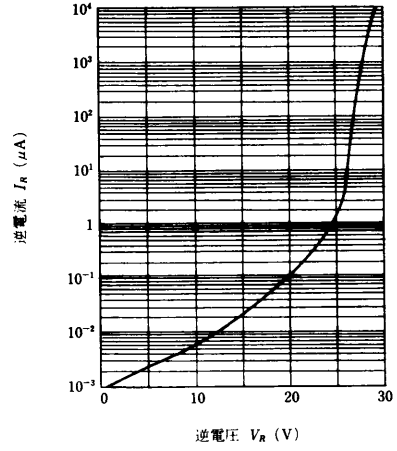
順特性

FORWARD CHARACTERISTICS



逆特性

REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量对逆電圧特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

